



GaSe（硒化镓）太赫兹晶体



产品描述：

GaSe（硒化镓）晶体的太赫兹振荡能达到有非常宽的频域，至41THz。GaSe是负单轴层状半导体晶体，拥有六边形结构的62m空间点群，300K时禁带宽度为2.2eV。GaSe晶体抗损伤阈值高，非线性系数大（54pm/V），非常合适的透明范围，以及超低的吸收系数，这使其成为中红外宽带电磁波振荡的非常重要的解决方案。

因宽带太赫兹振荡和探测使用的是低于20飞秒的激光光源，GaSe发射-探测系统能获得与ZnTe可比的甚至更好的结果。通过对GaSe晶体厚度的选取，我们可以实现对THz波的频率可选择性控制。

注：GaSe晶体的解理面为(001)，因此对该晶体使用的一个很大限制在于质软，易碎。

产品特点：

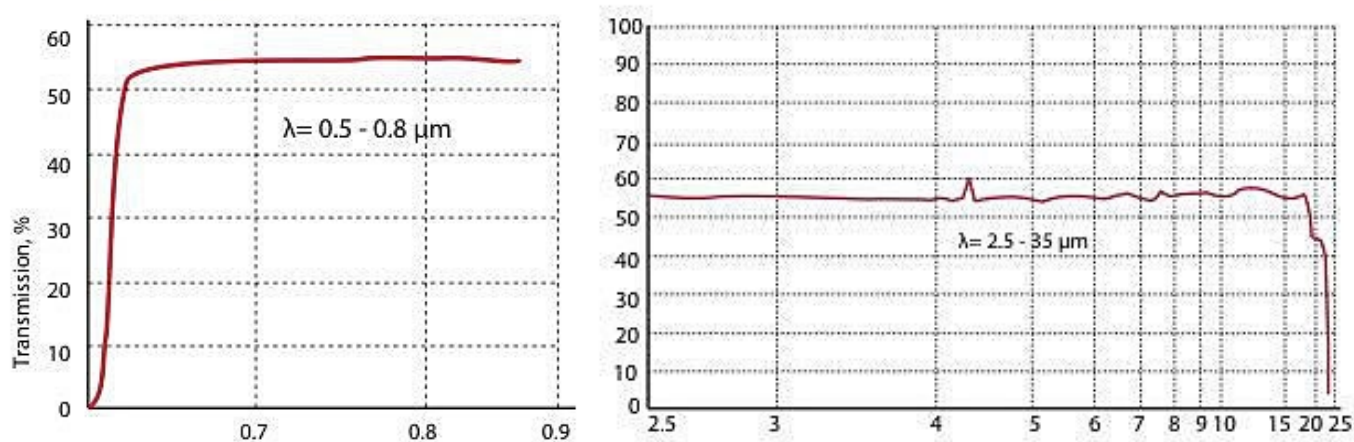
- ☀ 太赫兹振荡能达到有非常宽的频域
- ☀ 抗损伤阈值高
- ☀ 非线性系数大
- ☀ CO2激光的SHG
- ☀ 多种尺寸可选
- ☀ 客户导向的解决方案
- ☀ 接受客户定制服务

应用领域:

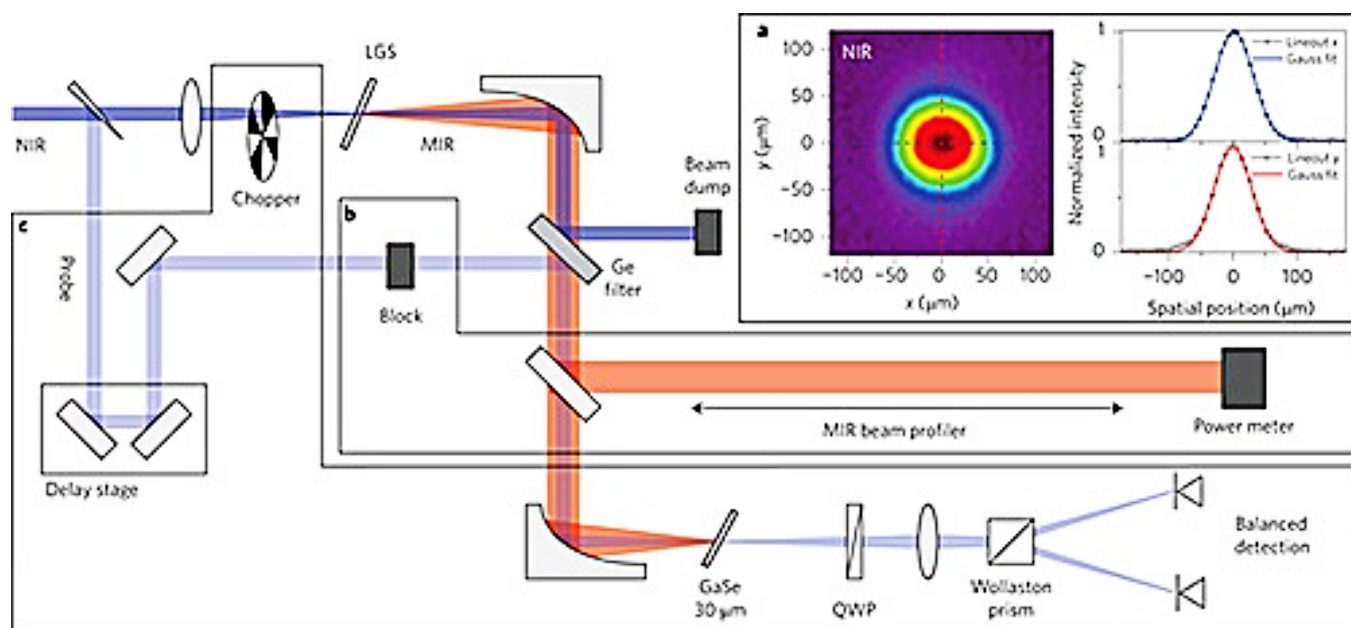
- ☀ 太赫兹时域系统
- ☀ 太赫兹源晶体
- ☀ 中远红外气体探测
- ☀ CO₂激光的SHG
- ☀ THZ实验光源
- ☀ 太赫兹成像

技术参数:

GaSe晶体的透过率曲线:



实验室光路系统:



EOS测量及反演结果:

